

CAPÍTULO 13

Elementos circuitales concentrados activos (*continuación*)

Mark B. Barron

General Electric Microelectronics Center
Research Triangle Park, North Carolina

Henry Domingos

Clarkson University
Potsdam, Nueva York

George H. Ebel

Singer Company
Wayne, New Jersey

- 13.1 Diodos, rectificadores, varistores**
 - 13.1.1 Diodos de unión *pn*
 - 13.1.2 Rectificadores de potencia
- 13.2 Transistores bipolares**
 - 13.2.1 Acción de transistor
 - 13.2.2 Parámetros de los transistores
 - 13.2.3 Tipos de transistores de potencia
 - 13.2.4 Transistores Darlington
 - 13.2.5 Consideraciones para las aplicaciones de los transistores
- 13.3 Transistores de efecto de campo**
 - 13.3.1 Transistores de efecto de campo con compuerta aislada
 - 13.3.2 Transistor de efecto de campo de unión (JFET)
 - 13.3.3 Variaciones de los MOSFET
 - 13.3.4 Consideraciones de aplicación
- 13.4 Circuitos integrados**
 - 13.4.1 Introducción
 - 13.4.2 Fabricación de circuitos integrados
 - 13.4.3 Circuitos integrados bipolares
 - 13.4.4 Circuitos integrados MOS
- 13.5 Circuitos híbridos: de película gruesa y de película delgada**
 - 13.5.1 Descripción general
 - 13.5.2 Definición de términos
 - 13.5.3 Procesos de manufactura
 - 13.5.4 Especificaciones de corriente
 - 13.5.5 Consideraciones térmicas
 - 13.5.6 Consideraciones sobre frecuencias
 - 13.5.7 Aplicaciones
 - 13.5.8 Referencias generales
- 13.6 Otros dispositivos electrónicos**
 - 13.6.1 Tiristores
 - 13.6.2 Transistores uniunión
 - 13.6.3 Otros dispositivos semiconductores
 - 13.6.4 Tubos de vacío
 - 13.6.5 Tiratrones

Nº 2913

VOLUMEN 2